
СОДЕРЖАНИЕ

Том 45, номер 3, 2016

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Нанoeлектромеханические алмазные структуры в квантовой информатике. Часть II

А. В. Цуканов

163

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование травления высокоаспектных канавок в Si в плазме смеси Cl₂/Ar

А. С. Шумилов, И. И. Амиров, В. Ф. Лукичев

177

Математическая модель поляризации тонкопленочных электродов

*И. А. Кузнецова, А. Н. Куликов, Т. Л. Кулова, А. В. Метлицкая,
А. А. Мироненко, А. С. Рудый, А. М. Скундин*

190

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Изучение влияния шага плазменного травления на шероховатость стенок канала Fin FET в схеме гетероинтеграции

Г. В. Баранов, А. П. Миленин, М. Р. Бакланов

197

Формирование рельефных рисунков из серебра и селенида цинка методом “взрывной” фотолитографии

Д. В. Лысич, С. В. Зеленцов, В. Е. Котомина, И. Н. Антонов

203

ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Нелинейная СВЧ модель низкобарьерного диода на основе полупроводниковых переходов

И. В. Юнусов, В. А. Кагадей, А. Ю. Фазлеева, В. С. Арыков

208

Детектирование терагерцевого излучения резонансно-туннельными наногетероструктурами

В. И. Егоркин, В. В. Капаев

217

МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Нестационарные фазовые переходы в системах металлизации кремниевых структур

А. А. Скворцов, С. М. Зуев, М. В. Корячко

227

Анализ технологических особенностей при изготовлении структур КНИ МЭМС-преобразователей

Н. М. Парфёнов

235

Вниманию авторов

240
